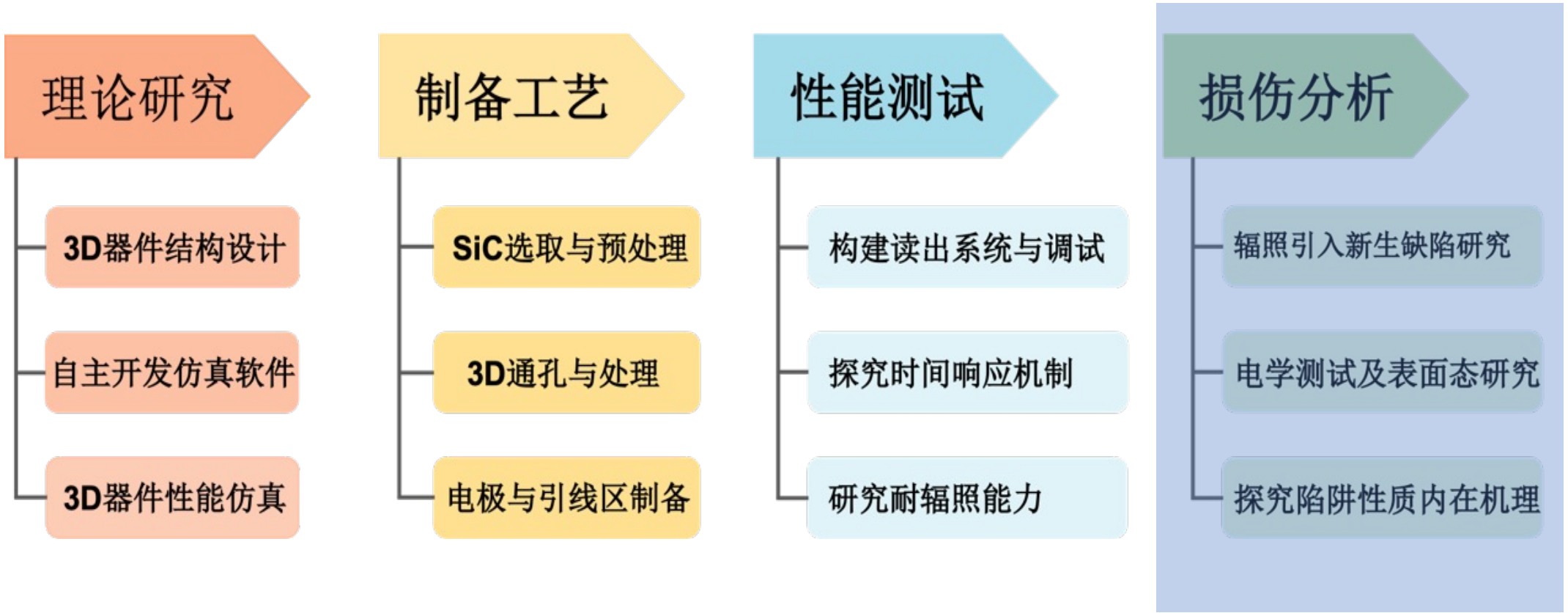
碳化硅探测器 – 损伤分析

史欣

2022年9月30日

技术路线


理论研究
3D器件结构设计
自主开发仿真软件
3D器件性能仿真
制备工艺
SiC选取与预处理
3D通孔与处理
电极与引线区制备
性能测试
构建读出系统与调试
探究时间响应机制
研究耐辐照能力
损伤分析
辐照引入新生缺陷研究
电学测试及表面态研究
探究陷阱性质内在机理

会议日程

10:00 AM → 10:05 AM **损伤分析**

Speaker: Xin Shi (IHEP)

10:05 AM → 10:30 AM **金半接触及金属化工艺**

Speaker: 晓川 夏 (Dalian University of Technology)

10:30 AM → 10:50 AM **Electrical Characteristics of Neutron-irradiated GaN Shottky Barrier Diodes**

Speaker: 嘉祥 陈 (shanghaiTech University)

10:50 AM → 11:10 AM **碳化硅损伤分析研究**

Speaker: 希媛 张